





(19) Japan Patent Office

(11) Unexamined Patent Application Publication No. Sho 49-122292

(43) Published on November 22, 1974

(21) Patent Application No. Sho 48-33213

(22) Filing Date: March 22, 1973

Request for examination: not yet

(52) Japanese Classification: 99(5) J 4, 99(5) C22

JPO reference No. 7377 57, 6851 57

Request for patent (1)

March 22, 1973

To: Commissioner of Patent Office

Title of the invention: MANUFACTURING METHOD OF LIGHT-EMITTING DIODE

WITH IR-VISIBLE LIGHT CONVERSION FUNCTION

Inventor: Tonao YUASA

c/o Nippon Denki Kabushiki Kaisha, 7-15, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo Applicant: (423) Nippon Denki Kabushiki Kaisha, 7-15, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo

Koji KOBAYASHI, President

Representative: (6591) Shin UCHIHARA, Patent Attorney

c/o Nippon Denki Kabushiki Kaisha, 7-15, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Tel (452)1111

Specification

Title of the Invention: MANUFACTURING METHOD OF LIGHT-EMITTING DIODE WITH IR-VISIBLE LIGHT CONVERSION FUNCTION Claim(s)

A manufacturing method of a light-emitting diode with an IR-visible light conversion function, comprising: forming a recess in the shape of truncated cone or similar shape at the center of a diode stem; mounting a pellet including a p-n junction and emitting infrared light, on the bottom of the recess; dropping a given amount of an IR-visible light conversion phosphor material into the recess to form an IR-visible light conversion phosphor layer with a given thickness around said pellet; dropping an adhesive onto the layer; heating them to solidify and fix the IR-visible light conversion phosphor material around said pellet; and performing lens-sealing or molding.









Partial English translation (from p.2, column 3, l.18 to p.2, column 6, l.19)

According to the present invention, a diode stem 11 as shown in Fig. 2 is employed. At the center of the diode stem, a recess 3 in the shape of truncated cone or similar shape is formed. A pellet 6 including a p-n junction and emitting infrared light is mounted on the bottom of the recess 3 which has the truncated cone or similar shape, as shown in Fig. 2. Next, as shown in Fig. 3, an adequate amount of an IR-visible light conversion phosphor material is dropped into the recess 3 from above the stem 11 to form a phosphor layer 7 around the pellet 6. If the dropped amount of the phosphor material is constant, the thickness of the phosphor layer 7 is always constant.

Next, in order to improve the adhesion between the phosphor layer 7 and the pellet 6, as shown in Fig. 4, an adequate amount of a thermoplastic resin 5 is dropped. In this case, the thermoplastic resin 5 has a suitable viscosity and is, for example, a silicon resin or an epoxy resin. Then, the thermoplastic resin 5 and the phosphor layer 7 configured as shown in Fig. 4 are gradually heated to penetrate the thermoplastic resin 5 into the phosphor layer 7. After hardening with heating, lens-sealing or molding with an epoxy resin is performed.

In the above-described manufacturing process, the injection of the IR-visible light conversion phosphor material 7 is performed using an injector apparatus 4 such as an injector as shown in Fig. 3. Also, the dropping of the silicon resin or epoxy resin is performed using a dropping apparatus 8 such as an injector as shown in Fig. 4.. In these processes, the stem 11 is sequentially moved to the positions immediately below the injector apparatus 4 and the dropping apparatus 8. First, when the recess 3 having the truncated cone or similar shape of the stem 11 is positioned immediately below the injector apparatus 4, the injector apparatus 4 drops the phosphor material into the recess 3 to form the phosphor layer 7. Then, the stem 11 is moved to be positioned immediately below the dropping apparatus 8. The dropping apparatus 8 then drops the silicon resin or epoxy resin into the recess 3. This can achieve a fully-automated operation of phosphor coating. Consequently, operations are simplified to decrease the required process steps. In addition to this, the thickness of the phosphor layer 7 is always controlled to be constant. This can achieve high reproducibility for the visible light output. The thus manufactured light-emitting diode having an IR-visible light conversion function can reflect the emitted IR light with the use of the recess 3 in the shape of truncated cone or similar shape. Accordingly, the amount of IR light absorbed by the phosphor material increases, thereby increasing the output of visible light.





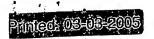




Brief Description of the Drawings

Fig. 1 is a schematic view showing the structure of a diode stem and an infrared light-emitting diode mounted thereon, for illustrating a conventional manufacturing method. In the drawing, reference numeral 1 denotes the diode stem, and 2 a pellet emitting infrared light and having a p-n junction.

Figs. 2, 3, and 4 are diagrams for illustrating the present invention. Fig. 2 is a schematic view showing the structure of a diode stem and an infrared light-emitting diode mounted, in which reference numeral 3 denotes a recess in the shape of truncated cone, 6 a pallet having a p-n junction and emitting infrared light, and 11 a diode stem. Fig. 3 is an explanatory view showing the process of forming an IR-visible light conversion phosphor layer, in which reference numeral 3 denotes the recess in the shape of truncated cone, 4 an apparatus for injecting a phosphor material, 6 the pellet having a p-n junction and emitting infrared light, 7 a phosphor layer, and 11 the diode stem. Fig. 4 is a view for explaining the drop of an adhesive, in which reference numeral 3 denotes the recess in the shape of truncated cone, 5 a thermoplastic resin, 6 the pellet having a p-n junction and emitting infrared light, 7 the phosphor layer, 8 a dropping apparatus for dropping the thermoplastic resin, and 11 the diode stem.









公開特許公報

許

特

· A 年. 昭和

願(/)

40 3.22

特許庁長官 殿

発明の名称

(2,000円)

etがイカ シヘンカンパクコウ 食外可視変換発光ダイオ

発

重点和港区艺五丁目7番15号 日本電気株式会社内



珊

東京都港区芝五丁目7都15号 (423)日本電気株式会社 代表者 社 及 小 林 宏 治

芝五丁117 街15号 〒 108 東京都

日本電気株式会社内 (6591) 弁理士 内 原 7825 (452)1111(大代表)

48 033213.

赤外可視変換発光ダイオードの製 発明の名称 造方法

特許請求の範囲

ダイオードステムの中央串に円錐台形もしくは 円銀台形に類似した形状の凹みを設け、凹みの &に P-n 接合を含み赤外級を発光するペレット を設着し、一定量の赤外可視変換会光体を出み **に発し、顔配ペレットの周囲に一定の身さの水** 外可視変換優先体の指を形成せしめ、さらにそ の上に接着剤を執下し、加熱し:赤外可視変換 優先体を前記ペレットの周囲に位者せしめ、さ られレンく對止あるいはモール! しることを好 ほとする赤り可視変換発光ダイオードの製造方 法。

平明の詳細な訳明

本范明性亦外可拘束片首片体· r 将体材料办与 戦る P−x 総合を含み赤外級をお付けるペレット

①特開昭 49 - 122292

43公開日 昭49.(1974)11.22

21特顯昭 48 - 332/3

②出顯日 昭45.(1973)分.22

審査請求 未請求

(全3頁)

庁内整理番号

52日本分類

7377 57 6851 57 996)14 9910C22

から補成された永外可決変換発光ダイオードの製 造方法に関するものである。

シリコンをドナータよびアクセプター不純物と して用いた単化ガリウムから成る アーs 装合を有し 赤外根を放射するペレットと何えば増感剤として イッテルビウム,活性剤としてエルビウムを用い **た弗化イットリウム装光体を組み合わせた赤外町** 役変換発光ダイオードはよく知られている。かか る蛯光ダイオードの製造においては,従来優先体 をシリコン国際でたはエポキン側庭にませ合わせ て、前1四のどとくダイオードステム1トに比較 された、P-n 接合を含み外外地を放射するペック トまの周囲に適当な市具を用いて顕微鏡下で取る ととにより行なわれているが、との方法ではペレ ァトの大きさが通常 45 × 45 mm の小さな面ねてあ り。その上に1==程度の厚さに乗允保を監布しな ければならないので、作業が非常に内臓であり、 時間がかかり工政が多く。しかも示布された歴光 体の厚さは背後性に乏しかつた。といため可視尤 の山刀のはらつをが不をくなり,しからペレット

(:)









より出た赤外光が十分に利用されたいため可視光 の母皮が低くなるという欠点があつた。

本発明の目的は上述のどとき欠点を有する赤外 可視変換発光ダイオードの製造方法を改良し。か つ自動化可能な製造方法を提供するととにある。

本発明によればダイオードステムの中央部に円 織台形もしくは円錐台形に類似した形状の凹みを 殴け、凹みの底に >-●接合を含み赤外線を発光す るペレットを装着し,一定量の赤外町視変換祭光 体を凹みに落し,故配ペレットの周囲に一定の厚 10 さの赤外可視変換袋先体の層を形成せしめ,さら にその上に投着剤を減下し、加熱して赤外町視変 換盤光体を前記ペレットの周囲に固着せしめ,さ らにレンズ封止あるいはモールドすることを特徴 とする赤外可視変換発光ダイオードの製造方法が 18 得られる。

以下本発明にづいて図面により鮮送する。 本発明によれば第3回に示すようにダイオードス テムの中央部に円錐台形もしくは円錐台形に類似 した形状の凹み 3 を持つたダイオードステム11

世4かよび両下装置8の其下に順次移動せしめ。 まず焦3回に示すようにステム11の円錐台形も しくは円錐台形に類似した形状の凹みるが注入装 置るの実下にきたとき注入装置るにより低光体を 凹みるに第下せしめ登光体層すを形成し、次にス テム11を移動し凹みまが属下装置 8 の実下にき たとも凹みるにシリコン街駅ないしはエポキシ樹 股を描下としめれば螢光体量布は完全に自動的に 行なりととができる。そつて作業は簡単になり、 工数は減る。しかも螢光体層1の厚さを常化一定 10 に制御できるため、可視発光出力の再現性を高く **することが可能である。加りるにかかる手段によ** つて作られた赤外可視安集発光ダイオードは赤外 光心周囲の円錐合形もしくは円錐合形に無似した 形状の凹み』によつて反射されるために優光体に 18 吸収される赤外光が増加する。従つて可視光の出 力が増大するという特殊をも有する。

図面の簡単な説明

第1型は従来の製造方法を説明するための凶で

"温泉149-122292 2)

を用いる。 トール接合を含み赤外線を放射するペレ ット 4 は第 3 凶化示した円盤台形または円錐台形 に類似した凹み3の底に鼓集される。次に斜3図 化示すようにステム11の上方より適当量の赤外 可視変換絵尤体を凹みるに落し、ペレットもの周 囲に登光体展すを形成する。との際登尤体の量が 一定であれば螢光体脳!の彫さは怎に一定となる。

次に登光体層 9 とペレット 6 との密港度をよく するために、第4回のどとく、例えばシリコン樹 脳、またはエポキシ樹脂のような適当な粘度の熱 硬化性樹脂 5 を適当量強下する。第 6 図に示した 熱硬化性樹脂=と蟄光体層=を徐熱し,熱硬化性 樹脂多を製光体層りの中に浸透させ、さらに加熱 硬化させた後レンズ對止あるいはエポキシ樹脂化 よるモールドを行なり。

上述の製造過程において赤外可視変換.螢光体 7 の注入を第 3 図に示すような注射器のごとき注 入装置も、シリコン樹屋ないしはエポキシ樹脂の 演下も第4 図に示したよりな注射器のごとき 横下 装量 8 を用いて行ない,ステム11を前記注入袋

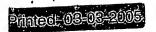
(4)

メイオードステムおよび装着されたお外発光メイ゛ オードの歓略構成図である。図にかいて1はダイ オードステム。9 は赤外線を放射し 7--*接合を有. するペレットを示す。

第3図、第3図、第4図は本発明を説明するた めの図で、第1回はダイオードステムと装着され た赤外苑光ダイオードを示す板略構成図であり、 3 は円錐台形状の凹み、6 は 2-6 接合を有し赤外 被を放射するペレット、11はダイオードステム を表わす。第3回は赤外可視変換優先体層の形成 1 の工程を説明する図であり、3 は円錐台形の凹み、 4 は接光体を注入するための装置。 ●は アール接合 を有し赤外線を放射するペレット。『は姜光休庵。 11はダイオードステムを扱わす。第4回は接着 幇の施下を説明する因であり、3 は円錐台形の凹 み,5は熱硬化性樹脂。6は 2-6 接合を有しお外 線を放射するペレット , 7 は低光体層 。8 は熱硬 化性樹脂の病下に用いる病下装置。11はダイオ ードステムを示す。

代学・サデ 門原

(4)



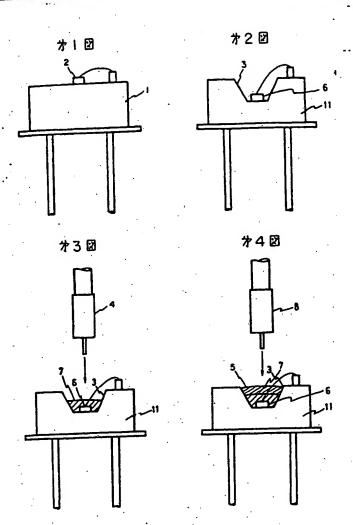


だ付む 類の目母



特別 昭49—122292 (3)

1通 1通 1通 1通



BEST AVAILABLE COPY

-455-